Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0400U002977

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 20-11-2000

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кучеєв Сергій Іванович
2. Kucheyev Sergij Ivanovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.15

Назва наукової спеціальності: Фізика молекулярних та рідких кристалів

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 25-10-2000

Спеціальність за освітою: 2016

Місце роботи здобувача: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02125674

Місцезнаходження: 14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.169.01

Повне найменування юридичної особи: Інститут монокристалів НАН України

Код за ЄДРПОУ: 00210217

Місцезнаходження: просп. Науки, 60, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61072, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02125674

Місцезнаходження: 14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.17.25

Тема дисертації:

1. Електрооптичні ефекти в структурах МДН-рідкий кристал, зумовлені перенесенням і накопиченням заряду

2. Electrooptic effects in MOS - liquid crystal structures due to transferring and storage of charge

Реферат/анотація:

1. Електрооптичні ефекти в структурах МДН-рідкий кристал. Дослідити взаємозв'язок процесів переносу і накопичення зарядів в структурах МДН-рідкий кристал з характеристиками електрооптичних ефектів, індукованих цими зарядами. Методами дослідження є електрооптичні, вольт-амперні та вольт-контрастні характеристикі. Виявлено, що накопичення заряду та його адсорбція в околі пори діелектрика індукує нестійкість гомеотропно та передпороговою переорієнтацію планарно орієнтованого нематика. Досліджено перехід в гомеотропний стан гібрідно-орієнтованого нематика, індукований зарядом. Виявлено ефект збіднення поверхні кремнію, індукований зарядами, накопиченими в рідкому кристалі. Виявлені і досліджені властивості доменів, індукованих локальними струмами через межу рідкий кристал-кремний. Результати використовуються в НДІ микропріладів, м. Киів. Сферою використання є фізика рідких кристалів, неруйнуючий контроль виробів електронної техніки

2. Electrooptic effects in MOS-liquid crystal structures. To determine the connection between charge processes and electrooptic effects induced by these processes. Methods of investigation are lectrooptical, volt-amper and volt-contrast characteristics. It has been found that charge accumulation and adsorption near a pore of dielectric film induce the instability of homeotrop and planar oriented nematic. It is shown that accumulation of charge induces the transition from the oblique to the homeotrop state of nematic in hybrid cell. It is shown that the accumulation of charge in liquid crystal cause the depletion of silicon surface and induce local domains. The results are used in R&D Institute of microdevices, Kiev. Field of application includes a liquid crystal physics, nondestructive testing of electronic products

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гриценко М.І.
2. Гриценко М.І.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лисецький Л.М.

2. Лисецький Л.М.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.14

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ковальчук О.В.

2. Ковальчук О.В.

Кваліфікація: к.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Толмачов О.В.

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Толмачов О.В.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.